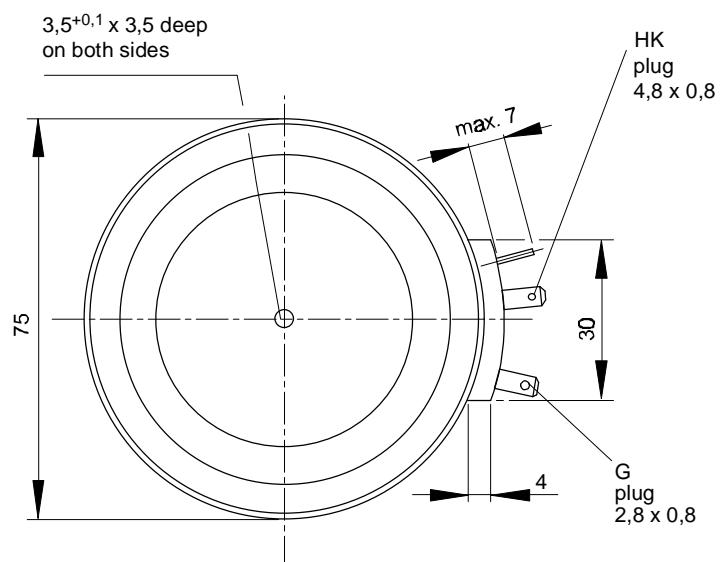
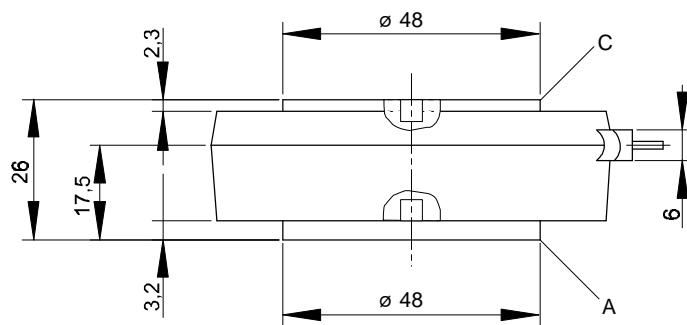


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company

Marketing Information T 729 N



T 729 N / T 730 N

Elektrische Eigenschaften

Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenmaximalspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltage	$t_{vj} = -40^\circ C \dots t_{vj\ max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	3600 3800 4000 V 4200
Vorwärts-Stoßspitzenmaximalspannung	non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ C \dots t_{vj\ max}$	V_{DSM}	3600 3800 4000 V 4200
Rückwärts-Stoßspitzenmaximalspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ C \dots t_{vj\ max}$	V_{RSM}	3700 3900 4100 V 4300
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current	I_{TRMSM}	1840 A	
Dauergrenzstrom	average on-state current	I_{TAVM}	730 A	
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	I_{TSM}	1170 A 17600 A 15800 A	
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$I^2 t$	1550000 $A^2 s$ 1250000 $A^2 s$	
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$(di_T/dt)_{cr}$	80 A/ μ s	
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$(dv_D/dt)_{cr}$	500 V/ μ s 1000 V/ μ s	

Charakteristische Werte

	Characteristic values		
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 3500 A$	V_T max. 3,4 V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$ 1,2 V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	r_T 0,57 mΩ
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 V$	I_{GT} max. 300 mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 V$	V_{GT} max. 2,5 V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6 V$	I_{GD} max. 20 mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD} max. 0,3 V
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 V, R_A = 2 \Omega$	I_H max. 300 mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 V, R_{GK} \geq 10 \Omega$	I_L max. 2500 mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R max. 200 mA
Zündverzug	gate controlled delay time	DIN IEC 747-6, $t_{vj}=25^\circ C, i_{GM}=1A, di_G/dt=1A/\mu s$	t_{gd} max. 3,5 μ s
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	$t_{vj}=t_{vj\ max}, i_{TM}=i_{TAVM}, V_{RM}=100 V, v_{DM}=0,67 t_q$ $v_{DRM}, dv_D/dt=20V/\mu s, di_T/dt=10A/\mu s, 4\ Kennbuchstabe/4th letter \Omega$	typ. 400 μ s

Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand

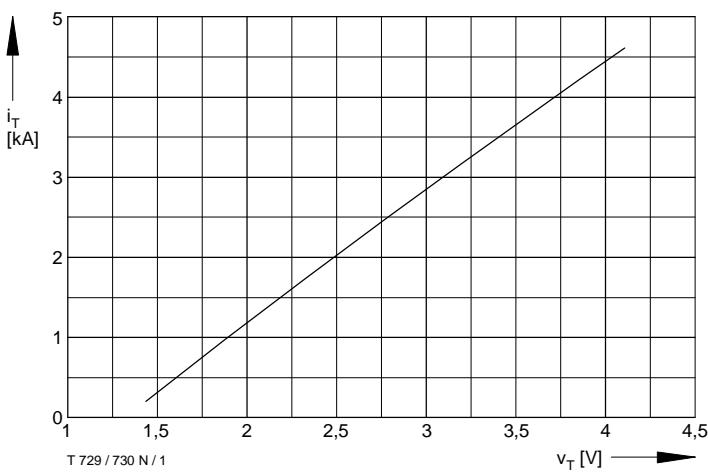
	thermal resistance, junction to case	R_{thJC}	
	beidseitig/two-sided, $\Theta = 180^\circ \text{ sin }$		max. 0,0215 °C/W
	beidseitig/two-sided, DC		max. 0,0200 °C/W
	Anode/anode, $\Theta = 180^\circ \text{ sin }$		max. 0,0405 °C/W
	Anode/anode, DC		max. 0,0390 °C/W
	Kathode/cathode, $\Theta = 180^\circ \text{ sin }$		max. 0,0425 °C/W
	Kathode/cathode, DC		max. 0,0410 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	R_{thCK}	
	beidseitig/two-sided		max. 0,0035 °C/W
	einseitig/single-sided		max. 0,0070 °C/W
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature	$t_{vj\ max}$	120 °C
Betriebstemperatur	operating temperature	$t_{c\ op}$	-40...+120 °C
Lagertemperatur	storage temperature	t_{stg}	-40...+150 °C

Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-Gate	Si-pellet with pressure contact,amplifying gate	Durchmesser/diameter 56 mm	
Anpreßkraft	clamping force	F	18...43 kN
Gewicht	weight	G	typ. 540 g
Kriechstrecke	creepage distance		30 mm
Feuchteklass.	humidity classification	DIN 40040	C
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 Hz$	50 m/s²
Gehäuse	Case		Titelseite / front page

Kühlkörper/heatsinks: K0.05F: K0.08F: 2K0.024W



T 729 / 730 N / 1

Bild / Fig. 1
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$
 $t_{vj} = t_{vj \max}$